## 05.4;07

# In situ контроль степени окисления порошков YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> методом спектроскопии диффузного отражения в ближней инфракрасной области

### © В.Н. Кузнецов, А.А. Лисаченко

НИИ физики им. В.А. Фока С.-Петербургского государственного университета E-mail: kuznets@photonics.phys.spbu.ru

### Поступило в Редакцию 24 декабря 2002 г.

Эволюция спектров диффузного отражения порошков YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> исследована в области  $0.5 \le hv \le 6.0 \text{ eV}$  для  $0.1 \le x \le \sim 1.0$ . Совмещение оптических измерений с термодесорбционной спектроскопией позволило выявить полосу 1.25 eV, которая обратимо изменяется в цикле восстановление  $\leftrightarrow$  окисление и может быть отнесена к межзонному поглощению в CuO<sub>2</sub> плоскостях с низкой координацией Cu(2). Показана возможность использования этой полосы для in situ контроля степени окисления порошков YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> при  $x \ge 0.5$ .

Зависимость оптических спектров YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> (YBaCuO<sub>7-x</sub>) от содержания кислорода обнаружена уже в ранних работах [1,2]. Это позволило использовать оптическую спектроскопию как для изучения природы высокотемпературной сверхпроводимости, так и для неразрушающего контроля дефицита по кислороду (параметра x). Для исследования монокристаллов и плотной керамики широкое распространение получила спектроскопия зеркального отражения, однако керамику перед измерениями необходимо полировать, что не позволяет проводить измерения in situ. Спектры зеркального отражения порошков практически не исследованы из-за малой амплитуды отражения. Усилить сигнал и исключить предварительную обработку образцов позволило бы использование диффузно отраженного излучения. Целью данной работы является анализ возможности применения спектроскопии диффузного отражения для in situ контроля изменения степени окисленности порошков YBaCuO<sub>7-x</sub> в ходе термообработки в вакууме и в O<sub>2</sub>.

24

Спектры диффузного отражения  $\rho(hv)$  измеряли в области 0.5  $\leq hv \leq 6.0 \,\text{eV}$  с помощью спектрофотометра Beckman UV 5270 с интегрирующей сферой относительно эталона BaSO<sub>4</sub>. Исследуемый порошок YBaCuO<sub>7-x</sub> помещали в кварцевую кювету, снабженную системами сверхвысоковакуумной откачки, напуска газов, а также регистрации температуры и давления. Спектры термодесорбции (ТД) измеряли на спектрофотометрической и масс-спектрометрической [3] установках. Основная часть опытов проведена с порошком YBaCuO<sub>7-x</sub>, полученным из керамики с  $x \approx 0.1$ , созданной в НИИ физики СПбГУ спеканием порошков оксидов.

На рис. 1 приведены спектры диффузного отражения исходного порошка (кривая 1) и порошка, прокаленного на воздухе при 1200 К (кривая 1a), а также типичные спектры образцов керамики различных партий (кривые 2, 2a). На кривых 1 и 1а видны монотонный рост величины диффузного отражения в области  $h\nu < 2 \,\mathrm{eV}$  и полосы с максимумами при 2.4-2.5, 4.5-4.6, 5.2-5.3 eV. Эти же особенности присутствуют и в спектрах диффузного отражения керамики. Указанные спектральные особенности характерны также для спектров зеркального отражения плотной полированной керамики [1,2] и монокристаллов  $YBaCuO_{7-x}$  [4]. Так, в спектрах зеркального отражения монокристаллов УВаСиО<sub>7-*x*</sub> для Е ∥ а и Е ∥ b поляризаций света наблюдаются полосы 2.78 и 2.84, 4.52 и 4.62, 5.32 и 5.3 eV соответственно [4]. После прокалки порошка при 1200 К на воздухе с последующим быстрым охлаждением в спектре диффузного отражения появляется полоса  $\sim 4.1 \, \text{eV}$  (рис. 1, кривая 1a), которая проявляется также в спектрах зеркального отражения полированных керамик и монокристаллов при  $x \ge 0.5$  [1,2,4]. Таким образом, спектры диффузного отражения порошков содержат все основные особенности спектров зеркального отражения монокристаллов и полированной керамики.

На рис. 2 приведены спектры диффузного отражения порошка до откачки (кривая *I*) и после вакуумирования при различных температурах (кривые 2–4). Вакуумирование при 290 К подавляет отражение в области hv < 1.5 eV. Это можно объяснить потерей кислорода при вакуумировании, что ведет к уменьшению концентрации свободных электронов. Как следствие, уменьшается друдевское отражение, а граница плазменного отражения смещается в низкоэнергетическую область. При 290 <  $T \leq 740$  К спектры изменяются слабо (кривая 2), но при T = 900 К проявляются полосы 1.3 и 4.1 eV (кривая 3).



**Рис. 1.** Спектры диффузного отражения порошка (1, 1a) и керамики YBaCuO<sub>7-x</sub> (2, 2a). На врезке спектры смещены по оси ординат. Пояснения в тексте.

После вакуумирования при T = 1000 K (кривая 4) полоса 1.25 eV становится доминирующей. Таким образом, рост полос 1.25 и 4.1 eV при термовакуумировании повторяет изменения в спектрах зеркального отражения монокристаллов и полированных керамик при увеличении x в области  $x \ge 0.5$  [1,2,4].

Поскольку в спектрах диффузного отражения кислородно-дефицитных порошков полоса в ближней инфракрасной (near infrared (NIR)) области (далее NIR полоса) доминирует, подробно исследовали ее изменения в ходе обработки в вакууме и в O<sub>2</sub>. На рис. 3, кривая *Ia* 



**Рис. 2.** Спектры диффузного отражения порошка YBaCuO<sub>7-x</sub> до откачки (1) и после вакуумирования при  $290 \le T \le 740$  (2), 900 (3), 1000 K (4).

приведена зависимость изменения интенсивности NIR полосы ( $\Delta \rho_{\text{NIR}}$ ) от температуры вакуумирования. Величину  $\Delta \rho_{\text{NIR}}$  рассчитывали как разность значений  $\rho$  на 1.25 eV, измеренных после вакуумирования при комнатной и заданной температурах. Из рис. 3 видно, что рост интенсивности NIR полосы начинается с  $T \approx 800$  K. Согласно данным работы [5], приведенным на врезке рис. 3, такой обработке соответствуют значения  $x \approx 0.5$ . При этих же значениях x NIR полоса появляется и в спектрах зеркального отражения керамики [1,2].

На рис. 3, кривая 3a приведен ТД-спектр кислорода (зависимость скорости десорбции  $V_d$  для m/e = 32 и от T при линейном нагреве). Из



**Рис. 3.** Зависимость изменения интенсивности NIR полосы  $(\Delta \rho_{\text{NIR}})$  от температуры прокалки в вакууме (*1a*, *1b*) и O<sub>2</sub> (*2*) длительностью 30 min, а также температурные зависимости скорости выделения (*V<sub>d</sub>*) (*3a*, *3b*) и поглощения (*V<sub>a</sub>*) кислорода образцом (*4a*, *4b*). Скорость нагрева  $\beta = 0.1$  (*3a*, *3b*), 0.3 (*4a*, *4b*) deg/s. Давление кислорода P = 100(2), 0.1 Torr (*4a*, *4b*). Пояснения в тексте. На врезке — зависимость *x* от температуры вакуумирования из работы [5].

кривых *1а* и *За* следует, что NIR полоса появляется после выделения пика кислорода при 835 К. Ранее в ТД-спектрах  $O_2$  из YBaCuO<sub>7-x</sub> в области ~ 850 К наблюдали один или два слаборазрешенных пика при 730-770 и 820-870 К [6,7], которые связали с выделением кис-

лорода из орторомбической фазы. Появление NIR полосы в спектрах зеркального отражения керамики связывают с переходом YBaCuO<sub>7-x</sub> из орторомбической в тетрагональную фазу [1,8]. К тетрагональной фазе YBaCuO<sub>7-x</sub> отнесен пик в TД-спектре при  $\sim$  1020 K [5,6]. Таким образом, условия появления NIR-полосы в данной работе согласуются с известными зависимостями ее интенсивности от параметра x и изменениями структуры YBaCuO<sub>7-x</sub>.

Интенсивность NIR полосы контролировали также в процессе реокисления порошка в  $O_2$  при P = 100 Torr. Для порошка YBaCuO<sub>7-x</sub>, предварительно вакуумированного при 1000 K, зависимость  $\Delta \rho_{\rm NIR}$  от температуры прокалки в O<sub>2</sub> длительностью 25 min приведена на рис. 3. Кривая 2 показывает, что NIR полоса практически полностью отжигается в интервале  $400 \leqslant T \leqslant 580$  К при P = 100 Torr. На образце, вакуумированном при 1000 К, измеряли также температурные зависимости скорости поглощения кислорода образцом  $V_a$  ( $V_a = dP/dt$ ) в ходе нагрева с постоянной скоростью при P = 0.1 Torr (рис. 3, кривые 4a, 4b). Из зависимостей  $V_a$  от T видно, что  $T \approx 400 \,\mathrm{K}$  является температурной границей поглощения кислорода из газовой фазы. (Кривые 4а и 4b соответствуют 1- и 3-му нагреву в серии последовательных нагревов). Методом ТД масс-спектрометрии с использованием изотопа <sup>18</sup>О показано, что при  $T \ge 400 \,\mathrm{K}$  начинается интенсивное встраивание адсорбированного кислорода в структуру YBaCuO<sub>7-x</sub> [3]. Таким образом, приведенные данные показывают возможность оптически контролировать изменение содержания структурного кислорода в YBaCuO<sub>7-х</sub> в ходе его обмена с газовой фазой при обратимости изменений NIR полосы в цикле восстановление ↔ окисление.

Кривая *1b* на рис. З представляет зависимость интенсивности NIR полосы от температуры вакуумирования образца, предварительно окисленного прокалкой в O<sub>2</sub>. Перед измерением зависимости *1b* часть кислорода, соответствующую пику при 850 K, удаляли в ходе ТД измерения. После этого выделение кислорода заметно лишь при  $T \ge 800$  K (рис. 3, кривая *3b*), а интенсивность NIR полосы соответствует точке, отмеченной на кривой *1b* значком \*. Последующие точки этой кривой получены при прокалке в вакууме длительностью 30 min. Из кривых *1b* и *3b* рис. 3 следует, что рост NIR полосы вызван удалением структурного кислорода на этапе перехода в тетрагональную фазу при T > 800 K. Таким образом, установлен полностью обратимый характер изменения интенсивности NIR полосы в цикле восстановление  $\leftrightarrow$  окисление по-

рошка YBaCuO<sub>7-x</sub>. Выделение структурного кислорода при  $T \ge 800$  К приводит к появлению NIR полосы, а поглощение кислорода при  $T \ge 400$  К — к ее исчезновению.

Обсудим природу полосы 1.25 eV. NIR полосу приписывают оптическому переходу с переносом заряда между зонами О  $p\sigma_{\rm r}$ ,  $p\sigma_{\rm v}$ и Си  $d_{x2-y2}$ , принадлежащими кислородным плоскостям CuO<sub>2</sub> [8–11]. Возникновение этой полосы связывают с удалением кислорода из Cu(1)O(1) плоскостей и переходом кристалла в тетрагональную фазу. В таком состоянии кристалл становится диэлектриком с заселенной O2p и свободной Cu3d зонами. Изменения приведенной плотности состояний проявляются как в спектрах поглощения, так и в спектрах отражения. Вместе с тем данные об условиях отжига NIR полосы при окислении YBaCuO7-x в литературе отсутствуют. В нашей работе показано, что NIR полоса отжигается в О2 в достаточно узком температурном интервале  $400 < T \le 580 \,\mathrm{K}$  (рис. 3, кривая 2). Анализ диффузии изотопа <sup>18</sup>О в керамику YBaCuO<sub>7-r</sub> показал, что на первом этапе при 600-720 К занимаются структурные позиции O(1) и О(5) [12]. Диффузию кислорода в порошки контролировали и при более низких температурах  $T \ge 523 \, \text{K}$  [13]. Толщина окисленного слоя при T = 500 K, P = 760 Torr и времени прокалки 25 min, рассчитанная нами на основании данных работы [13], составляет ≤ 30 nm. Таким образом, отжиг NIR полосы в  $O_2$  обусловлен заполнением позиций O(1)и реконструкцией исходной орторомбической фазы в приповерхностной области.

Положение максимума NIR полосы в спектрах отражения керамик и тонких пленок смещается в пределах от ~ 1.4 до ~ 1.7 eV [1,2,14,15] в зависимости от числа атомов кислорода (*N*), координированных с Cu(2) [8,9]. Так, в La<sub>2</sub>CuO<sub>2</sub> при *N* = 6 (двух вершинных кислородах O(4), которые с CuO<sub>2</sub> плоскостью образуют октаэдр) NIR-полоса наблюдается при 2.0 eV, при *N* = 5 (пирамидальной ячейке в LaGdCuO<sub>4</sub> — при 1.7 eV, а при *N* = 4 (без вершинных кислородов в Nd<sub>2</sub>CuO<sub>4</sub> и CaCuO<sub>2</sub>) она смещена к 1.5 eV [8,9]. Максимумы при 1.7–1.8 и 1.4–1.5 eV наблюдаются и на спектральных зависимостях эффективности наведения фотопроводимости в кислородно-дефицитном YBaCuO<sub>7-x</sub> [16,17]. Авторы [17] связали максимум 1.4–1.5 eV с фотоэлектрически активным поглощением света дефектами в CuO<sub>2</sub> плоскостях на границе зерен. В связи с этим отметим, что NIR полоса наблюдалась при 1.5 eV и в спектрах зеркального отражения монокри-

сталлов YBaCuO<sub>7-x</sub> тетрагональной фазы, измеренных для границы областей двойникования [18]. Таким образом, максимум оптического поглощения различных купратов в области межзонных переходов в CuO<sub>2</sub> плоскостях смещается в диапазоне 1.3-1.8 eV. Меньшие значения этого диапазона соответствуют поглощению на границах кристаллитов и областей двойникования, где координация Cu(2) может быть ниже, чем в объеме. Из изложенного следует, что полоса 1.25 eV в спектрах диффузного отражения порошков может быть обусловлена межзонным поглощением в поверхностных (приповерхностных) низкокоординированных CuO<sub>2</sub> плоскостях.

Полученные результаты показывают, что полосу 1.25 eV можно использовать для in situ неразрушающего контроля изменения содержания кислорода при формировании и разрушении орторомбической фазы порошков YBaCuO<sub>7-x</sub>. Использование диффузного отражения не требует предварительной обработки образцов, позволяет интегрировать отраженный сигнал в значительном телесном угле, в широких пределах изменять геометрию расположения образца и системы регистрации относительно зондирующего луча. В качестве источника зондирующего излучения можно использовать Nd лазер с hv = 1.14 eV.

Выводы.

1. Спектры диффузного отражения порошков и керамики  $YBaCuO_{7-x}$  в области  $0.5 \le h\nu \le 5.5 \, eV$  повторяют спектры зеркального отражения монокристаллов и полированных керамик.

2. Интенсивность полосы 1.25 eV в спектре диффузного отражения УВаСuO<sub>7-x</sub> коррелирует с параметром x при  $x \ge 0.5$ , что позволяет использовать ее для in situ дистанционного контроля стехиометрии порошков YBaCuO<sub>7-x</sub>.

# Список литературы

- Kelly M.K., Barboux P., Tarascon J.M. et al. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 1. P. 870–873.
- [2] Humlicek J., Garriga M., Cardona M. // Sol. State Commun. 1988. V. 67. N 6. P. 589–592.
- [3] Кузнецов В.Н. // Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. В. 10. С. 1-8.
- [4] Довгий Я.О., Карплюк Л.Т., Китык И.В. и др. // ФТТ. 1990. Т. 32. № 10. С. 3099–3102.

- [5] Кирьяков Н.В., Григорьян Э.А., Сихарулидзе Ю.Г. и др. // Сверхпроводимость. Физика. Химия. Технология. 1990. Т. 3. № 6. С. 1121–1127.
- [6] Семин В.В., Назаренко А.В., Хабаров С.Э. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15.
  В. 7. С. 72–75.
- [7] Hegde M.S. // Mat. Res. Bull. 1988. V. 23. N 8. P. 1171-1176.
- [8] Kelly M.K., Barboux P., Tarascon J.M., Aspnes D.E. // Phys. Rev. B. 1989.
  V. 40. N 10. P. 6797–6805.
- [9] Tokura Y., Takagi H., Arima T. et al. // Physica C. 1989. V. 162–164. P. 1231– 1232.
- [10] Leng J.M., Ginder J.M., Farneth W.E. et al. // Phys. Rev. B. 1991. V. 43. N 13. P. 10582–10588.
- [11] Cooper S.L., Reznik D., Kotz A. et al. // Phys. Rev. B. 1993. V. 47. N 13. P. 8233-8248.
- [12] Выходец В.Б., Куренных Т.Е., Трифонов К.И. и др. // ЖЭТФ. 1994. Т. 106. № 2. С. 648–662.
- [13] Conder K., Kruger Ch. // Physica C. 1996. V. 269. P. 92-98.
- [14] Geserich H.P., Scheiber G., Geeerk J. et al. // Europhys. Lett. 1988. V. 6. N 3. P. 277–282.
- [15] Widder K., Munzel J., Goppert M. et al. // Physica C. 1998. V. 300. P. 115-124.
- Budko S.L., Feng H.H., Davis M.F. et al. // Phys. Rev. B. 1993. V. 48. N 22.
  P. 16707–16713.
- [17] Markowitsch W., Stockinger C., Lang W. et al. // Phys. Stat. Sol. (b). 1999.
  V. 215. N 1. P. 547–551.
- [18] Petrov M.P., Grachev A.I., Krasin'kova M.V. et al. // Sol. State Commun. 1988.
  V. 67. N 12. P. 1197–1200.